Data Sheet

Central™ Semiconductor Corp.
145 Adams Avenue, Hauppauge, NY 11788 USA
Tel: (631) 435-1110 • Fax: (631) 435-1824

Manufacturers of World Class Discrete Semiconductors

1N3600
1N4150

SILICON SWITCHING DIODE

JEDEC DO-35 CASE

DESCRIPTION

The CENTRAL SEMICONDUCTOR 1N3600, 1N4150, silicon planar epitaxial diode is characterized by its miniature size, ultra fast switching speed, low capacitance, low leakage, and high conductance. Accordingly, it is ideally suited for applications such as pulse applications, avalanche circuits, core drivers, and for any critical circuit requiring high conductance at power dissipation without sacrificing fast recovery capability. (Both devices have identical electrical and mechanical specifications).

MAXIMUM RATINGS (T_A=25°C)

	SYMBOL		UNIT
Peak Working Inverse Voltage	V_{RWM}	50	V
Average Forward Current	I_O	200	mA
Forward Steady State Current	I_F	400	mA
Recurrent Peak Forward Current	i_f	600	mA
Peak Forward Surge Current (1.0s Pulse)	I_{FSM}	1.0	A
Peak Forward Surge Current (1.0µs Pulse)	I_{FSM}	4.0	A
Power Dissipation	P_D	500	mW
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{STG}	-65 to +200	°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_A=25°C unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNIT
I_R	V_R=Rated V_{RWM}		100	nA
I_R	V_R=Rated V_{RWM}, T_A=150°C		100	µA
BV_R	I_R=5.0µA	75		V
V_F	I_F=1.0mA	0.54	0.62	V
V_F	I_F=10mA	0.66	0.74	V
V_F	I_F=50mA	0.76	0.86	V
V_F	I_F=100mA	0.82	0.92	V
V_F	I_F=200mA	0.87	1.0	V
C	V_R=0V, f=1.0MHz		2.5	pF
t_{fr}	V_{fr}=1.0V, I_f=200mA, t_r=0.4ns		10	ns
t_{rr}	I_f=I_r=10mA to 200mA, R_L=100Ω		4.0	ns
t_{rr}	I_f=I_r=200mA to 400mA, R_L=100Ω		6.0	ns

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Central Semiconductor:

1N4150 1N3600 1N3600 TR

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9